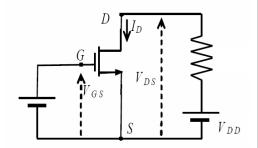
0.1 Condensadors

 $\frac{\text{Capacitat}}{\text{Càrrega}} \frac{\varepsilon \varepsilon_0 A/d}{q = CV}$ Energia electroestàtica: $W = E = \frac{1}{2}CV_C^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

1 Diodes

Eq. de Shockley: $I = I_0 \left(e^{\frac{V}{\eta V_\tau}} - 1 \right)$ $V_\tau = \frac{k_B T}{e}, \eta \approx 1, I_0 =$ corrent saturació inversa Eq. de Planck: $E = h\nu$ $h = 6,62 \times 10^{-34}$ [Js]

2 Transistors



2.1 Transistors NMOS

 $\begin{array}{l} \text{if } (V_{GS}>V_T)\\ \text{if } (V_{DS}>V_{GS}-V_T) \text{ (1)}\\ \text{else (2)}\\ \text{else (3)} \end{array}$

(1) <u>zona de saturació</u>: $I_D = \frac{\beta}{2}(V_{GS} - V_T)^2$

(2) zona lineal (óhmica):

$$\beta \left[\left(V_{GS} - V_T \right) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$
(3) zona de tall: $I_D = 0$

2.2 Transistors PMOS

 $\begin{array}{ll} \text{if } (V_{GS} < V_T) \\ \text{if } (V_{DS} < V_{GS} - V_T) \text{ (1)} \\ \text{else (2)} \\ \text{else (3)} \\ \end{array}$

(1) <u>zona de saturació</u>:

$$I_D = \frac{\beta}{2}(V_{GS} - V_T)^2$$

(2) zona lineal (óhmica):

$$\beta \left[\left(\overline{V_{GS} - V_T} \right) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

(3) zona de tall: $I_D = 0$

3 Retras i potència en circuits digitals

Interruptor de:

càrrega $C \approx 1[F]$ tensió d'alimentació V_{DD} relació d'activitat pcorrent Iclock f_C

Potència dinàmica de càrrega:

$$\overline{P_{\text{dinàmica}}} = p f_C C V_{DD}^2$$

Potència estàtica: $P_{\text{estàtica}} = IV_{DD}$

Potència dissipada:

$$\overline{P = P_{\text{dinàmica}} + P_{\text{estàtica}}}$$

Energia de commutació:

$$E = CV_{DD}^2 + \frac{IV_{DD}}{pf_C}$$

4 Varis

Nombre d'Avogadro: $N_A = 6,22 \times 10^{23}$